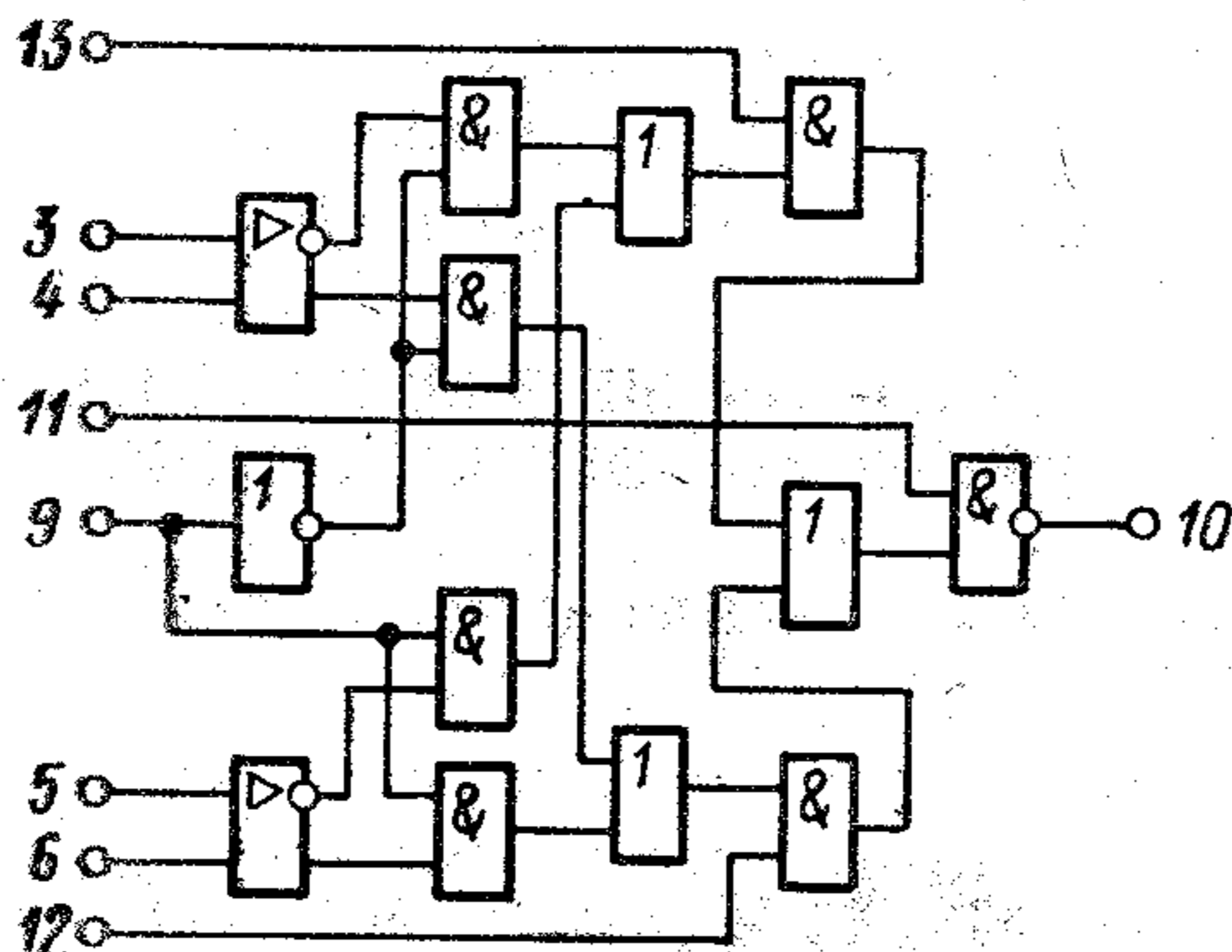


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 — напряжение порога $U_{пор}$ | 9 — вход управления каналами W |
| 2 — напряжение смещения $U_{см}$ | 10 — выход Y |
| 3 — вход $X1$ | 11 — строб-вход S |
| 4 — вход $X2$ | 12 — управление полярностью 1 |
| 5 — вход $X3$ | 13 — управление полярностью 2 |
| 6 — вход $X4$ | 14 — +5 В |
| 7 — минус 5 В | |
| 8 — общий | |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В	$\pm 5 \pm 10\%$
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения, мА:	
по выводу 1, не менее	минус 1,2
» » 7, не менее	минус 26
» » 14, не более	36
Входной ток, мА:	
низкого уровня, не менее	
по выводу 11	минус 1,6
» выводам 9, 12, 13	минус 1,0
высокого уровня, не более	
по выводу 11	0,04
» выводам 9, 12, 13	0,025

Выходное напряжение, В:	
низкого уровня, не более	0,4
высокого уровня, не менее	2,4
Время задержки распространения при включении, нс, не более	50

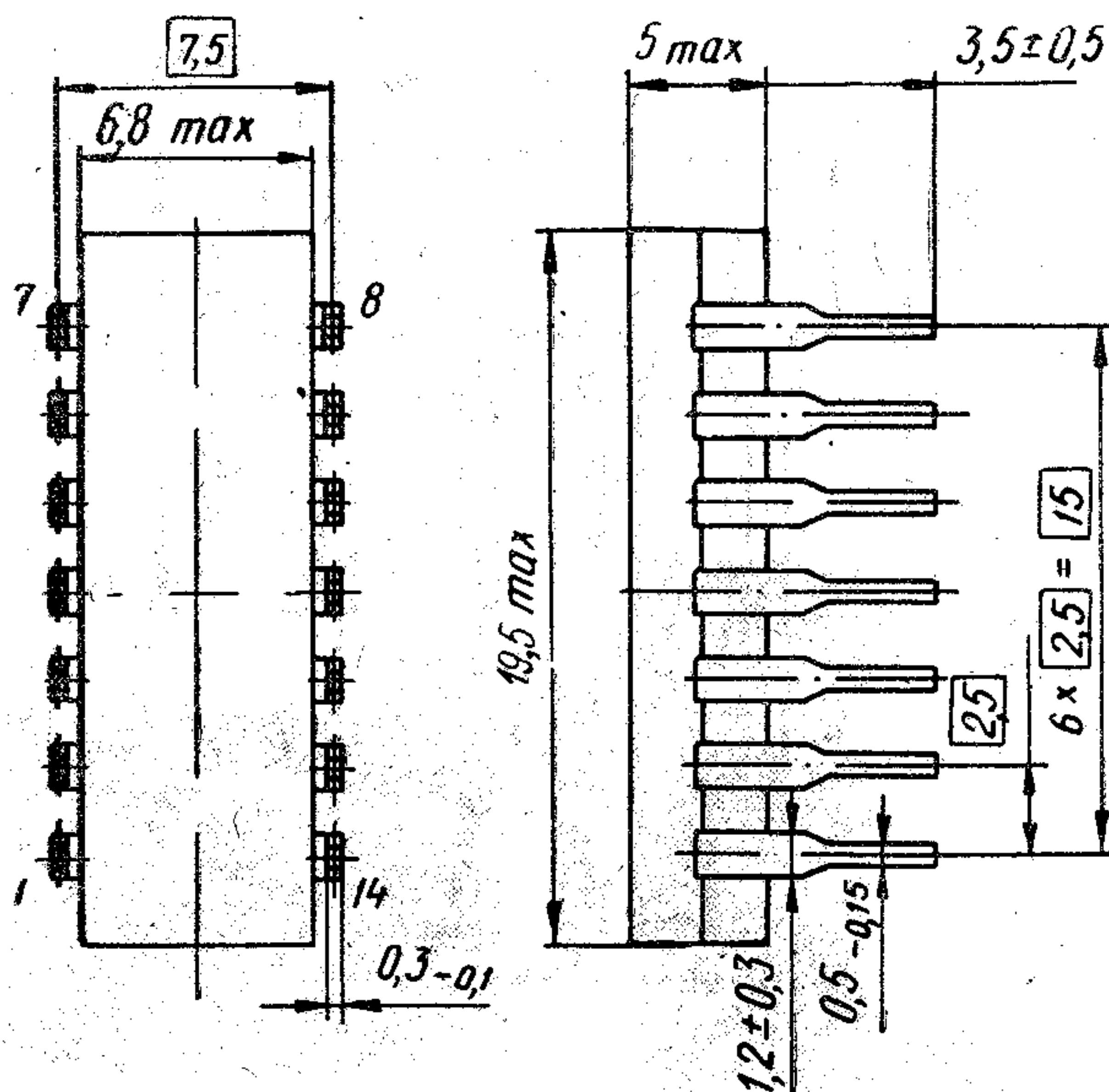
**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Максимальное напряжение питания (кратковремен- но в течение 5 мс), В:	
по выводу 7	7
» » 14	минус 7
Максимальное напряжение на выходе закрытой схе- мы (кратковременно в течение 5 мс), В	7
Напряжение между выводами 3 и 4 или 5 и 6 (крат- ковременно в течение 5 мс), В:	
максимальное	2
минимальное	минус 2
Максимальное напряжение питания порога (кратко- временно в течение 5 мс), В	минус 7,5
Напряжение питания смещения (кратковременно в течение 5 мс), В	от минус 2 до +2
Напряжение на выводах 3—6, В:	
максимальное	4,5
минимальное	минус 4,5
Напряжение на строб-входах, В	от 0 до 5,5

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 170

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МИКРОСХЕМ (КОРПУС 201.14-2)



Масса не более 1 г

Нумерация выводов микросхем показана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	400 (40)

Механический удар:

одиночного действия

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) . . .	10 000 (1000)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

многократного действия

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5

Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	5000 (500)
--	------------

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 170

Общие данные

Акустический шум:	
диапазон частот, Гц	50—10 000
уровень звукового давления, дБ	160
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.):	
для микросхемы 170АП2	$1,3 \cdot 10^{-4}$ (10^{-6})
» остальных микросхем	665 (5)
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, °С	70
Пониженная температура среды, °С	минус 10
Изменения температуры окружающей среды, °С	от минус 10 до +70
Повышенная относительная влажность при температуре 35°С, %	98
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка \ominus , ч	50 000
Срок сохраняемости \ominus , лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин «питание» и «земля») к выводам микросхем, используемым согласно схеме.

При ремонте аппаратуры и при контроле параметров микросхем в контактирующих устройствах замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

При работе с микросхемами должны быть приняты меры по защите от воздействия электростатического заряда.

Предельное значение электростатического потенциала 500 В.

\ominus В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.